

КРЕМНИЕВЫЕ МИКРОМОДУЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ М-10Б—М-11А (р-п-р)

Конструктивное оформление — металлический герметизированный колпачок, устанавливаемый на микромодульной плате, с выводами, распаянными к пазам (см. рис. 233).

Вес 0,8 г.

Интервал рабочих температур от $+120$ до -60°C .

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре 40°C .

Интервал изменений атмосферного давления от 5 мм рт. ст. до 2 ати. Допускается применение транзисторов при атмосферном давлении до $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.

Наибольшее постоянное ускорение 150 g.

Наибольшее ускорение при многократных ударах 150 g.

Наибольшее допустимое ускорение при вибрациях с частотами 5—2000 гц 10 g.

Микротранзисторы монтируются на микромодульных платах размером $9,6 \times 9,6 \times 3,1$ мм и обозначаются буквами ТМ или М. Электроды транзисторов распаяются по пазам микромодульной платы: 1 — база, 5 — эмиттер, 8 — коллектор.

Рабочее положение — любое.

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого назначения с микромодульным исполнением.

Параметры транзисторов приведены в табл. 117.

Таблица 117

Параметры	Тип транзистора		
	М-10Б	М-11	М-11А
Предельная частота усиления по току, Мгц	0,5	0,1	0,5
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером	40—160	9—36	15—60
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей базой, в	—20	—10	—20
Наибольшая рассеиваемая мощность, мвт	150	150	150